

Библиографический список

1. Панин В. Е. Физическая мезомеханика и компьютерное конструирование материалов. – Новосибирск: Наука, 1995. – Т. 1, II.
2. Осташев В. В., Самаркин А. И., Шевченко О. Д. Резонансно-поисковый метод анализа процесса развития пластических деформаций в поликристаллах // Научные ведомости БГПУ, 1996. – С.72-76.
3. Осташев В.В., Шевченко О.Д. Динамические особенности пластической деформации поликристаллов // Письма в ЖТФ, 1998. – Т.25. – Вып. 16. – С.50.
4. Шевченко О.Д., Осташев В.В., Федюкин В.К. Виды бифуркаций и аттракторов при пластической деформации поликристаллов: Труды ППИ, 1998. – № 2. – С.142-147.
5. Осташев В.В., Шевченко О.Д. Физические основы управления свойствами конструкционных сталей: Труды ППИ, 1997. – № 1. – С. 118-123.

УДК 539 374

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В ОБЛУЧЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ

Н. В. Камышанченко, В. В. Красильников, В. В. Сирота, Н.А. Чеканов

Белгородский государственный университет

И.М. Неклюдов, А.А. Пархоменко

ИНЦ Харьковский физико-технический институт

В последнее время широкое распространение получил синергетический подход к описанию эволюции пластической деформации в материалах (см., например, Г. А. Малыгин, ФТТ, т. 37, в.1, с.3-42). В основе такого подхода лежат кинетические уравнения для локальной плотности дислокации $\rho(\vec{x}, t)$ (x – пространственная координата, t – время), учитывающие различные процессы взаимодействия движущихся дислокаций друг с другом и другими дефектами кристалла. Существенную роль при этом играет то обстоятельство, что данная физическая модель адекватно описывает процессы различных взаимодействий, происходящих в кристаллах под воздействием как внутренних, так и внешних напряжений. Существует несколько теоретических подходов к изучению процессов, происходящих при коллективном поведении дислокаций. При этом, как правило, в используемых эволюционных уравнениях для плотности дислокаций $\rho(\vec{x}, t)$ нелинейность процессов пластичности представлена членами, квадратичными по плотности дислокаций ρ^2 (см., например, Г. Ф. Сарафанов, ФММ, т. 85,

в. 3, с. 45-53, (1998); Ш. Х. Ханнанов, ФММ, т. 85, в. 5, с. 11-20, (1998)).

В настоящей работе представлена модель, описывающая в синергетическом подходе формирование дислокационных структур в облученных деформированных материалах под влиянием нелинейных эффектов, связанных с наличием неоднородного распределения дислокаций. Используются эволюционные уравнения, описывающие коллективное поведение дислокаций, учитывающие так называемую нелинейность Бюрджерса, то есть члены типа $\rho(\partial\rho/\partial x)$. Сходные идеи использовались для анализа эволюции дислокационных структур на основе нелинейного уравнения Бюрджерса в работе Г. Ф. Сарафанова, С. Н. Нагорных «Физика прочности и пластичности материалов». (Тезисы докладов XIV Междунар. конф., Самара, 1995 г., с.59-60). В основе нашей модели лежит гидродинамическое описание системы движущихся дислокаций с помощью локальной плотности дислокаций $\rho(\vec{x}, t)$ и плотности потока $\vec{j}(\vec{x}, t)$ дислокаций как потока «квазичастиц», подчиняющихся уравнению баланса:

$$\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} + \text{div} \vec{j}(x,t) = J\{\rho(x,t)\}, \quad (1)$$

где $J\{\rho(x,t)\}$ - функционал плотности дислокаций, описывающий их взаимодействие друг с другом.

Рассмотрим упрощенную модель кристалла, для которой движущиеся дислокации скользят в одной плоскости в некотором определенном направлении, задаваемом осью Ox , и имеют одинаковый знак заряда. Легко видеть в этой модели, что скорость скольжения дислокаций является, вообще говоря, функционалом плотности дислокаций $V(\rho)$. Скорости скользящих дислокаций V можно представить состоящей из трех частей: $V = V_{ext} + m(f_{int} + f_{cor})$, где V_{ext} - скорость, обусловленная внешней нагрузкой; m - подвижность дислокаций, f_{int} - сила внутренних напряжений, вызываемая, например, дислокационными зарядами [Ш. Х. Ханнанов, ФММ, т. 78, в. 2, с. 31-39, (1994)], для которой можно предложить следующую формулу:

$$f_{int} = b \int K(x-x', t-t') \rho(x', t') dx' dt', \quad (2)$$

где b - величина вектора Бюргерса, $K(x-x', t-t')$ - функция, обусловленная нелокальным влиянием плотности дислокаций и потоков дислокаций, также зависящих от их плотности, и определяемая функцией Грина упругой задачи.

В приближении слабой неоднородности в главном приближении по пространственным градиентам из (2) получим:

$$f_{int} \approx b K_0 \rho(x,t),$$

$$K_0 = \int K(x-x', t-t') dx' dt'. \quad (3)$$

Для f_{cor} - корреляционной силы, возникающей за счет взаимного расположения дислокаций, используем выражение (см. Ш. Х. Ханнанов, ФММ, в. 10, с. 34-41. (1992)):

$$f_{cor} = \frac{Gb^2}{4\pi\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \eta \frac{Gb^2}{8\pi\rho_0^2} \frac{\partial^3 \rho}{\partial x^3}, \quad (4)$$

где G - модуль сдвига, ρ_0 - некоторая средняя стационарная плотность дислокаций, η - численный коэффициент.

Правую часть уравнения (1) часто представляют в виде:

$$J(\rho) = k_1 - k_2 \rho^2, \quad (5)$$

где k_1 характеризует источник дислокаций, k_2 ответственен за взаимодействие дислокаций, в частности, за процессы их аннигиляции.

В данной работе будем считать $J(\rho) \approx 0$. Физически это можно аргументировать следующим образом. Поскольку здесь нас будет интересовать пластическое течение в облученных материалах, то согласно недавним работам [B.N. Singh, A. Horsewell, P. Toft, D.J. Edwards., J. Nucl. Mater. v. 224, p. 131, (1995); B.N. Singh, D.J. Edwards, A. Horsewell, P. Toft, Rispr-R-839 (EN), Sept. (1995)], облучение оказывает огромное влияние на генерацию дислокаций, часто почти полностью ее подавляя, из-за сильной блокировки дислокационных источников мельчайшими кластерами межузельных атомов. Поэтому член k_1 может в определенных условиях быть близким к нулю.

Второе слагаемое в $J(\rho)$, содержащее k_2 , также испытывает сильное влияние облучения. В соответствии с нашими исследованиями [В. Н. Воеводин, Л. С. Ожигов, А. А. Пархоменко, Н. В. Камышанченко, В. В. Красильников, ВАНТ, Сер.: ФПИ и РМ, Вып.3(69), 4(70), 1998, с. 33-35] в облученных деформируемых материалах может происходить изменение свойств самих дислокаций (расширение ядер дислокаций, снижение энергии дефекта упаковки). Все это может привести к резкому снижению коэффициента k_2 в облученных материалах.

Функциональная зависимость скорости дислокаций V от плотности ρ дислокаций, выраженная формулами (3) и (4), приводит уравнение (1) в пренебрежении правой его частью ($J(\rho) \approx 0$) и слагаемым, пропорциональным четвертой производной $\partial^4 \rho / \partial x^4$, к виду:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(V_{ext} \rho + mb K_0 \rho^2 + \left(m \frac{Gb^2}{4\pi\rho_0} - D \right) \frac{\partial \rho}{\partial x} \right) = 0, \quad (6)$$

где D - коэффициент диффузии дислокаций.

Решение уравнения (6) будем искать в виде: $\rho(x,t) = \rho_0 + \rho_1(x,t)$, где $\rho_1(x,t)$ - функция плотности дислокаций около средней стационарной плотности ρ_0 дислокаций. Для флуктуации плотности $\rho_1(x,t)$ дислокаций уравнение (6) принимает вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \alpha \frac{\partial \rho_1}{\partial x} + \mu \rho_1 \frac{\partial \rho_1}{\partial x} + \gamma \frac{\partial^2 \rho_1}{\partial x^2} &= 0, \\ \alpha &= V_{ext} + 2mbK_0\rho_0, \quad \mu = 2mbK_0, \\ \gamma &= \frac{mGb^2}{4\pi} - D. \end{aligned} \quad (7)$$

Заметим, что возникновение члена $\mu \rho_1 \frac{\partial \rho_1}{\partial x}$ обязано внутренним напряжениям, создаваемым дислокациями. Анализ температурных зависимостей предела текучести облученных материалов (см. например, De Vries M. Proc. BNES Conf. on Irradiation Embrittlement and Creep. London: BNES, 1972, p. 47-52; В. Ф. Зеленский, И. М. Неклюдов, Л. С. Ожигов, А. А. Пархоменко, В. И. Савченко, ВАНТ. Сер.: ФРП и РМ. вып. 2(10), 1979, с. 61-66) показывает, что основной эффект влияния облучения нейтронами, высокоэнергетическими заряженными частицами связан именно с ростом внутренних напряжений, создаваемых радиационными дефектами. В силу этого член $\mu \rho_1 \frac{\partial \rho_1}{\partial x}$ в облученных материалах должен играть одну из главенствующих ролей. Делая замену переменных в $t\mu \rightarrow t$, приведем (7) к известному в гидродинамике жидкостей уравнению Бюргера:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_1 \frac{\partial \rho_1}{\partial x} &= -\delta \frac{\partial^2 \rho_1}{\partial x^2}, \\ \delta &= \frac{1}{2K_0b} \left(\frac{Gb^2}{4\pi} - \frac{D}{m} \right). \end{aligned} \quad (8)$$

Будем исследовать стационарное решение уравнения (9), имеющее следующий вид:

$$\rho(x,t) = a\delta \left(1 + th \frac{1}{2} (ax - a^2 t \delta) \right), \quad (9)$$

где a - постоянная, определяемая граничными условиями, в частности при условии,

что при $x - at\delta \rightarrow -\infty$ $\rho_1(x,t) \rightarrow 0$. Решение (9) соответствует краю полосы Чернова-Людерса.

Значительному влиянию облучения может быть подвержено отношение коэффициента диффузии дислокаций к их подвижности: D/m . Под коэффициентом диффузии дислокаций D будем понимать величину, связанную с так называемой нелокальной диффузией, обусловленной дальнедействующим взаимодействием между дислокациями [Г. А. Малыгин. ФТТ, т. 37, в.1, с. 3-42, (1995)]. Этот механизм описывает, например, расширение полос типа Чернова - Людерса на начальных этапах развития процесса пластической деформации. Будем считать, что количественно коэффициент диффузии дислокации может быть определен по формуле Эйнштейна

$$D = v_d k T / b \sigma_i, \quad (10)$$

где σ_i - величина внутренних напряжений, действующих в материале, v_d - скорость диффузионного дрейфа дислокаций, k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура. Для подвижной дислокации используем следующее выражение:

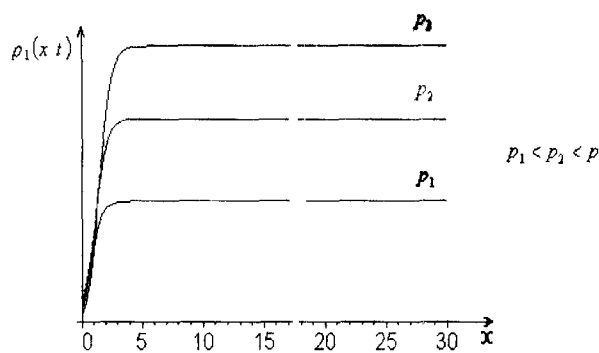
$$m = v V / b \sigma_a, \quad (11)$$

где V - средняя скорость скольжения дислокации, σ_a - напряжение пластического течения в плоскости скольжения, v - числовой коэффициент ($v \geq 1$). Величины напряжений σ_a и σ_i связаны соотношением $\sigma_a = \sigma_{ext} - \sigma_i$, где σ_{ext} - внешнее прикладываемое к образцу напряжение. При этом отношение D/m принимает вид:

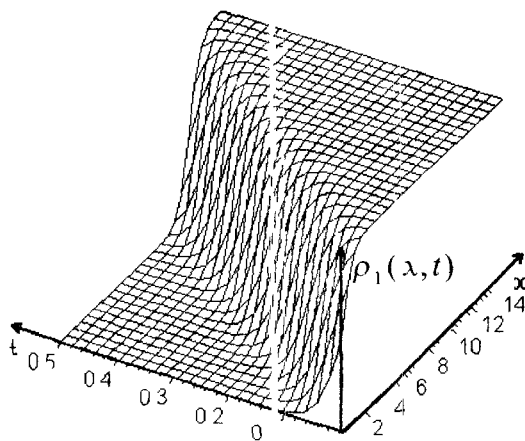
$$\frac{D}{m} = \frac{kT}{v} \cdot \frac{v_d}{V} \cdot \frac{\sigma_{ext} - \sigma_i}{\sigma_i}. \quad (12)$$

Отношение скоростей v_d/V в облученных материалах на этапе формирования полос локализованной дислокации резко уменьшается за счет значительного увеличения доли дислокаций, движущихся со скоростями порядка 0,1 c (c - скорость звука) в «псевдорелятивистском режиме» под действием напряжений σ_a [Н. В. Камышанченко, В. В. Красильни-

ков, И. М. Неклюдов, А. А. Пархоменко, ФТТ, т. 40, №9, с. 1631-1634, (1998)]. Со-множитель $(\sigma_{ext} - \sigma_i)/\sigma_i$ в формуле (12) также уменьшается с увеличением дозы об-лучения за счет значительного возрастания внутренних напряжений. В результате с увеличением дозы облучения отношение D/m будет уменьшаться, что приведет, в соответствии с формулой (8), к увеличению параметра δ , а следовательно, к увеличению высоты ступеньки (9) Это качественно иллюстрирует рис. 1 на котором изображены три графика, соответствующих решению (9), для трех значений дозы облучения $p_1 < p_2 < p_3$.



Р и с 1 Зависимость высоты ступеньки от дозы облучения



Р и с 2 Трехмерное изображение распро-странения ступеньки пластической деформации в плоскости скольжения

Отметим зависимость плотности дислокаций $\rho_1(x, t)$, определяемую решением (11), от температуры T

(11), от температуры T (термоактивацион-ный режим скольжения). Так как в этом случае для параметра v справедлива зави-симость $v = \Omega \sigma_a / kT$, где Ω - активацион-ный объем, то для отношения D/m вместо (14) имеем:

$$\frac{D}{m} = \frac{(kT)^2}{\Gamma \sigma_i} \cdot \frac{v_d}{V}, \quad (15)$$

откуда следует рост отношения D/m с увеличением температуры, а следователь-но, уменьшение параметра δ и высоты ступеньки для плотности дислокаций $\rho_1(x, t)$.

Данное уменьшение высоты сту-пеньки с увеличением температуры испы-таний согласуется с результатами работы [A. Luft, Prog. In Material Saence, v. 35, p. 97-204, (1991)].

Показано, что эволюция плотности дислокаций в деформируемых облучен-ных материалах может быть описана уравнением Бюргерса, в котором рост под облучением внутренних напряжений учи-тывается с помощью нелинейного члена типа $\rho \frac{\partial \rho}{\partial x}$. В результате решения уравнения

получена зависимость плотности дислока-ций в виде ступеньки, высота которой зави-сит от дозы облучения.

Рост высоты ступеньки вследствие облучения соответствует наблюдаемым в экспериментах результатам увеличения степени локализации деформации в по-лосах скольжения в облученных мате-риалах. Плотность дислокаций в них уже при дозах ≤ 1 смещения на атом более, чем на порядок выше по сравнению с плотностью дислокаций в полосах Чер-нова-Людерса в необлученных материа-лах [M. S. Wechsler in: The Inhomogeneity of Plastic Deformation. // ASM, Metals Park, Ohio, 1973, pp. 19-52].